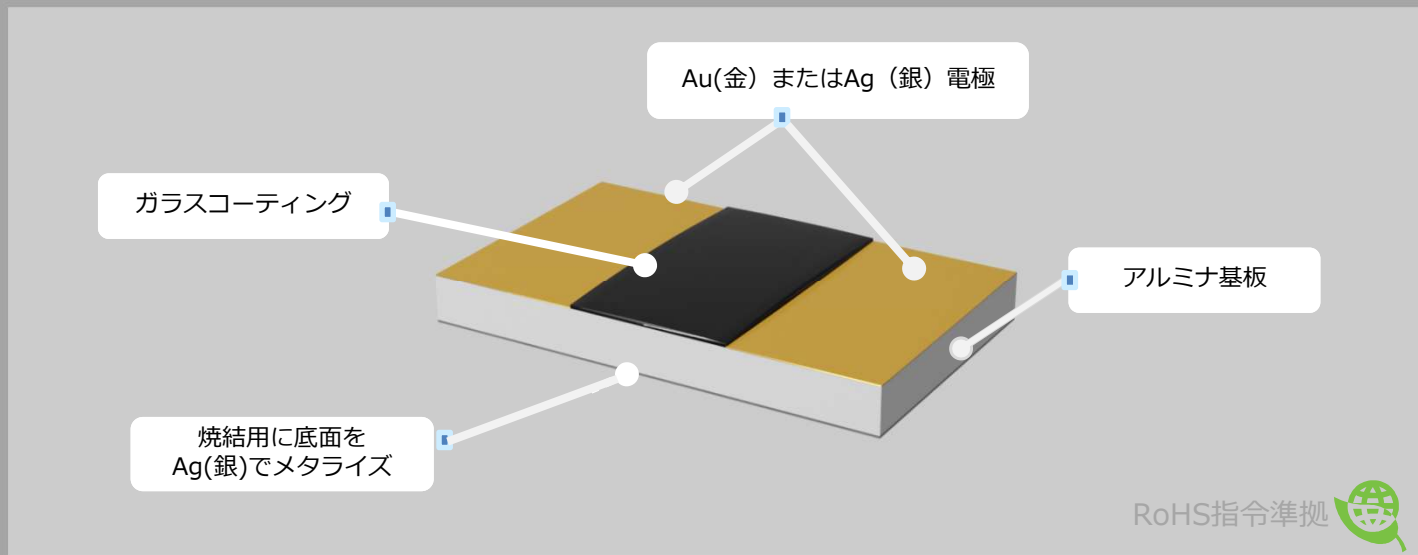




## 世界初、高温耐熱。サンプル対応可能

## 200℃耐高温ワイヤボンディング用厚膜チップサーミスタ



## 特徴

- SiC・GaNの高温動作に対応したKMDタイプの角形チップNTCサーミスタです。
- アルミナ基板上にサーミスタ膜を形成、ガラスで保護した構造で高い機械強度と信頼性が得られます。
- 表面電極は用途に合わせてAu(金)またはAg(銀)から選択することができます。
- 焼結やシタリングのため底面はAg(銀)をメタライズしています。
- 抵抗値に関係なく厚さが一定のため、実装基板の薄型化に貢献します。
- 独自の調合法により、お客様のご要望に合わせた抵抗値とB定数に調整することができます。
- 熱応答性が高く、熱容量が小さいため、温度変化に対して迅速に反応します。
- AEC-Q200にも対応可能です。

## アプリケーション

- SiC / GaN パワーモジュール
- EV / HEV 向けインバーター
- IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) の温度補償
- MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) の温度補償
- DC-DC コンバーター
- OBC (On-Board Charger) の温度管理
- 半導体、電子部品の温度補償
- ABS制御回路

製品の特性はお客様のご要望に応じてカスタマイズが可能です。詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。

## 仕様

チップサイズ	使用温度範囲	抵抗値(25℃)	B定数	定格電力	最大許容電力	熱放散定数(気中)	熱時定数(気中)	電極
1608mm	-40℃ ~ +200℃	1k ~ 500kΩ	3375 ~ 4500K	120mW	5mW	δ≦1.5mW/℃	τ≦5sec	Au(金)/Ag(銀)
2012mm		500 ~ 400kΩ		130mW				
3216mm		500 ~ 400kΩ		130mW			τ≦10sec	

